

АНОМАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И СОСУЩЕСТВОВАНИЕ АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМА СО СВЕРХПРОВОДИМОСТЬЮ ВБЛИЗИ КВАНТОВОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ В РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДАХ

B. B. Вальков^{a,b}, A. O. Злотников^a*

*^a Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук
660036, Красноярск, Россия*

*^b Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М. Ф. Решетнёва
660014, Красноярск, Россия*

Статья написана по материалам доклада
на 36-м Совещании по физике низких температур
(Санкт-Петербург, 2–6 июля 2012 г.)

Изучены механизмы возникновения аномальных свойств, экспериментально наблюдаемых при переходе через квантовую критическую точку в редкоземельных интерметаллидах. Квантовые фазовые переходы в этих материалах индуцируются внешним давлением и проявляются как разрушение дальнего антиферромагнитного порядка при нулевой температуре. Подавление дальнего упорядочения сопровождается увеличением площади поверхности Ферми, а в окрестности квантовой критической точки происходит сильная ренормировка эффективной массы электронов. Показано, что такая ренормировка обусловлена перестройкой квазичастичной зоны, ответственной за формирование тяжелых фермионов. Установлено, что эти особенности сохраняются и в том случае, когда вблизи квантовой критической точки реализуется фаза сосуществования антиферромагнетизма и сверхпроводимости.

DOI: 10.7868/S0044451013050170

1. Разрушение дальнего порядка при квантовом фазовом переходе связано с возрастанием в системе квантовых флюктуаций, интенсивность которых управляет контролем параметром (например, давлением) [1, 2]. В цериевых интерметаллидах приложение гидростатического давления при температурах ниже температуры Нееля подавляет дальний антиферромагнитный порядок, приводя к его резкому разрушению при квантовом фазовом переходе. При этом в окрестности квантовой критической точки наблюдается переход в сверхпроводящее состояние.

В последнее время особый интерес вызывает соединение CeRhIn₅, поскольку в нем реализуется однородная на микроскопических масштабах фаза сосуществования сверхпроводимости и антиферромагнетизма [3]. В формировании электронной

структурь этого соединения существенную роль играют ионы церия и коллективизированные *p*-состояния атомов индия [4]. Было показано, что между 4*f*-состояниями Ce и *p*-состояниями In реализуется гибридизационное смешивание [5]. Эти факторы лежат в основе предположения о том, что для качественного описания особенностей низкоэнергетического спектра фермиевских возбуждений CeRhIn₅ может быть выбрана периодическая модель Андерсона. При этом считается, что подсистема 4*f*-электронов является ответственной за формирование как антиферромагнитного упорядочения, так и куперовской неустойчивости.

Первый подход к проблеме квантовых критических точек связан с обобщением флюктуационной теории фазовых переходов для случая нулевых температур [6]. Было показано [7], что квантовые флюктуации могут вносить существенные поправки в термодинамические свойства коллективизированной электронной системы. Позднее для определения роли локализованных электронов в критической области

*E-mail: vvv@iph.krasn.ru

было предложено представление о локальной квантовой критической точке [8]. При переходе из paramagnитной области через такую критическую точку наряду с появлением дальнего антиферромагнитного порядка происходит нарушение кондо-режима, индуцируемого за счет $s-d(f)$ -связи между коллективизированными и локализованными электронами.

Переход через квантовую критическую точку в части тяжелофермионных систем сопровождается появлением аномальных свойств. Это относится, прежде всего, к эффективной массе электронов, зависимость которой от контрольного параметра демонстрирует расходимость в области квантового фазового перехода. Кроме того, происходит увеличение поверхности Ферми [9]. Эти эффекты были обнаружены при исследовании зависимости частот осцилляций де Гааза – ван Альфена в CeRhIn₅ от давления [10]. Дополнительная особенность связана с реализацией нефермийидкостного режима [11]. В частности, в соединении CeRhIn₅ температурная зависимость электросопротивления в области, прилегающей к квантовой критической точке, становится почти линейной [12]. Такая зависимость реализуется, например, в рамках двухзонной модели [13].

Отклонения от фермийидкостного поведения не всегда связываются с близостью к квантовой критической точке. Так, например, в рамках феноменологической двухжидкостной модели [14] предполагается, что ниже температуры когерентности термодинамические характеристики определяются двумя вкладами. Первый вклад связан с возникновением тяжелофермионного когерентного состояния, обусловленного гибридизацией между локализованными электронами и электронами проводимости. Второй вклад характеризуется оставшимися в системе изолированными кондо-примесями, на которых происходит спин-флуктуационное рассеяние.

К настоящему времени обсуждаются несколько сценариев аномального поведения эффективной массы и сечения поверхности Ферми. Один из них связан с нарушением кондо-режима в локальной квантовой критической точке [9]. В соответствии с этим сценарием при нарушении кондо-режима поверхность Ферми образуется только коллективизированными электронами. Поэтому площадь поверхности Ферми уменьшается. Другой механизм связан с наличием сильных валентных флуктуаций [15].

В настоящей работе в рамках расширенной периодической модели Андерсона проанализирована возможность реализации фазы сосуществования антиферромагнетизма и сверхпроводимости в тяжелофермионных интерметаллидах и показано, что

в окрестности квантовой критической точки имеет место аномальное увеличение эффективной массы электронов. При этом квантовый фазовый переход сопровождается резким изменением поверхности Ферми.

2. Для описания аномального поведения квазичастичных характеристик, наблюдаемого вблизи границы реализации антиферромагнитного состояния в тяжелофермионных соединениях, рассмотрим модель Андерсона в атомном представлении [16, 17]. В гамильтониане такой системы выделим эффективное взаимодействие, ответственное за формирование дальнего антиферромагнитного порядка:

$$\hat{H}_{eff} = \hat{H}_{PAM} + \hat{H}_{exch}. \quad (1)$$

Оператор \hat{H}_{PAM} представляет собой привычную запись гамильтониана периодической модели Андерсона в режиме сильных электронных корреляций:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{PAM} = & \sum_{m\sigma} (\varepsilon_0 - \mu) c_{m\sigma}^\dagger c_{m\sigma} + \sum_{ml\sigma} t_{ml} c_{m\sigma}^\dagger c_{l\sigma} + \\ & + \sum_{m\sigma} (E_0 - \mu) X_m^{\sigma\sigma} + \\ & + \sum_{ml\sigma} [V_{ml} c_{m\sigma}^\dagger X_l^{0\sigma} + V_{ml}^* X_l^{\sigma 0} c_{m\sigma}]. \end{aligned} \quad (2)$$

Здесь $c_{m\sigma}$ — фермиевские операторы, записанные в представлении Ванье, ε_0 — одноузельная энергия электронных состояний, t_{ml} — интеграл пересека. Затравочная энергия локализованных состояний обозначена посредством E_0 , μ — химический потенциал системы, $X_l^{\sigma\sigma}$ — квазифермиевские операторы Хаббарда. Интенсивность гибридизации волновых функций коллективизированных и локализованных электронов определяется матричными элементами V_{ml} .

Оператор \hat{H}_{exch} описывает взаимодействие между локализованными электронами:

$$\hat{H}_{exch} = \frac{1}{4} \sum_{ml\sigma} J_{ml} (X_m^{\sigma\bar{\sigma}} X_l^{\bar{\sigma}\sigma} - X_m^{\sigma\sigma} X_l^{\bar{\sigma}\bar{\sigma}}). \quad (3)$$

В периодической модели Андерсона такое взаимодействие возникает после учета высокоэнергетических гибридизационных процессов [18].

3. Для получения уравнений самосогласования воспользуемся методом неприводимых двухвременных температурных функций Грина [19] и техникой проецирования Цванцига – Мори. При описании антиферромагнитной фазы достаточно ограничиться двухподрешеточным набором базисных опе-

раторов (узлы f принадлежат F-подрешетке, g — G-подрешетке):

$$(X_f^{0\sigma}, Y_g^{0\sigma}, a_{f\sigma}, b_{g\sigma}). \quad (4)$$

Составляя уравнения движения для функций Грина по отмеченной методике и решая получающуюся систему уравнений, находим явные выражения для искомых функций Грина:

$$\begin{aligned} \langle\langle X_{p\sigma}|X_{p\sigma}^\dagger\rangle\rangle_\omega &= \frac{\alpha_\sigma S_{p\sigma}(\omega)}{d_4(p, \omega)}, \\ \langle\langle a_{p\sigma}|a_{p\sigma}^\dagger\rangle\rangle_\omega &= \frac{C_{p\sigma}(\omega)}{d_4(p, \omega)}. \end{aligned} \quad (5)$$

Первое выражение соответствует функции Грина для электронов в локализованной подсистеме. Второе — функции Грина для коллективизированных электронов. При этом использованы следующие обозначения:

$$\begin{aligned} S_{p\sigma}(\omega) &= (\omega - E_{\bar{\sigma}}) \left[(\omega - \xi_p)^2 - \Gamma_p^2 \right] - \\ &- \alpha_{\bar{\sigma}} (\omega - \xi_p) (V_p^2 + W_p^2) - 2\alpha_{\bar{\sigma}} \Gamma_p V_p W_p, \quad (6) \\ C_{p\sigma}(\omega) &= (\omega - E_\sigma) (\omega - E_{\bar{\sigma}}) (\omega - \xi_p) - \\ &- \alpha_{\bar{\sigma}} (\omega - E_\sigma) V_p^2 - \alpha_\sigma (\omega - E_{\bar{\sigma}}) W_p^2. \end{aligned}$$

Дисперсионное уравнение, определяющее энергетический спектр системы, получается приравниванием к нулю знаменателя найденных функций Грина:

$$\begin{aligned} d_4(p, \omega) &= (\omega - E_\sigma) (\omega - E_{\bar{\sigma}}) \left[(\omega - \xi_p)^2 - \Gamma_p^2 \right] + \\ &+ \alpha_\sigma \alpha_{\bar{\sigma}} (V_p^2 - W_p^2)^2 - [\alpha_\sigma (\omega - E_{\bar{\sigma}}) + \alpha_{\bar{\sigma}} (\omega - E_\sigma)] \times \\ &\times [(\omega - \xi_p) (V_p^2 + W_p^2) + 2\Gamma_p V_p W_p] = 0. \quad (7) \end{aligned}$$

Физический смысл введенных обозначений следующий. Ренормированное выражение для энергии локализованного уровня $E_\sigma = E_0 - \mu - J(n_L + 2\eta_\sigma R)$ включает поправку, связанную со среднеполевым влиянием обменного взаимодействия (вклад порядка $-Jn_L$), и вклад порядка $-2\eta_\sigma JR$ ($\eta_\sigma = \pm 1$, $\sigma = \uparrow, \downarrow$), приводящий к снятию вырождения этого уровня по проекции спинового момента. Величина $\xi_p = \varepsilon_0 + t_p - \mu$ соответствует отсчитанной от химического потенциала μ такой части кинетической энергии коллективизированных электронов, которая связана с внутриподрешеточными перескоками. Функции t_p , Γ_p , V_p и W_p определяются соответственно через фурье-преобразования $t_{ff'}$, t_{fg} , $V_{ff'}$, V_{fg} .

Среднее число локализованных электронов $n_L = \sum_\sigma \langle X_f^{\sigma\sigma} \rangle$ и намагниченность антиферромагнитной подрешетки $R = \sum_\sigma \eta_\sigma \langle X_f^{\sigma\sigma} / 2 \rangle$ являются неиз-

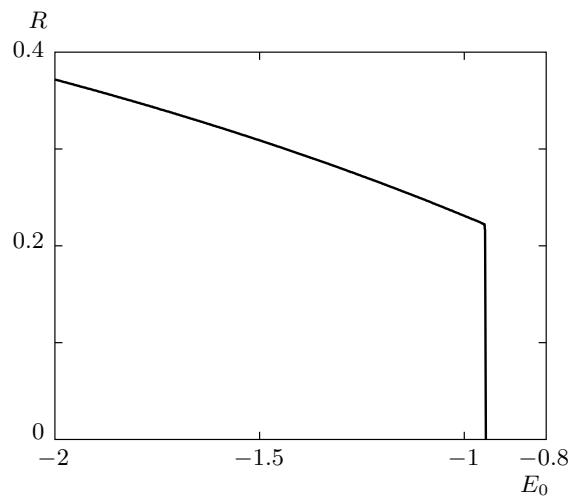


Рис. 1. Зависимость намагниченности антиферромагнитной подрешетки R от энергии локализованных состояний E_0 при концентрации электронов $n_e = 1.1$. Выбраны следующие значения параметров модели: $V_0 = 0.6$, $J = 0.2$

вестными величинами и характеризуют основное состояние системы. Через эти параметры определяется величина хаббардовской ренормировки для антиферромагнитной фазы $\alpha_\sigma = \alpha + \eta_\sigma R$ ($\alpha = 1 - n_L/2$ — стандартная ренормировка в парамагнитной фазе). Для расчета n_L и R воспользуемся процедурой самосогласования в уравнении, полученном по спектральной теореме:

$$\langle X_f^{\sigma\sigma} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{kj} \alpha_\sigma \frac{S_{k\sigma}(E_{jk}) f(E_{jk}/T)}{\prod_{i \neq j} (E_{jk} - E_{ik})}, \quad (8)$$

где $f(x) = 1/(e^x + 1)$ — функция Ферми–Дирака, значения индексов j , i изменяются от 1 до 4, что соответствует вкладу от четырех ветвей энергетического спектра E_{jk} в антиферромагнитной фазе.

На рис. 1 представлена зависимость намагниченности R от затравочной энергии локализованного уровня при нулевой температуре. Энергетические величины измеряются в единицах параметра перескока коллективизированных электронов между ближайшими соседями $|t_1|$. Видно, что по мере увеличения энергии E_0 величина намагниченности уменьшается. Когда величина E_0 достигает критического значения (квантовая критическая точка), намагниченность системы становится равной нулю (дальний антиферромагнитный порядок разрушается). Отметим, что подавление антиферромагнитного упорядочения в данном случае определяется изменением контрольного параметра E_0 . Изменение этого параметра, как обычно, связывается с действием внешнего давления.

4. Определение формы поверхности Ферми и значения эффективной массы проводятся на основе решения дисперсионного уравнения (7). Для упрощения выкладок ограничимся областью энергий, в пределах которой находится узкая гибридизованная зона,

$$\begin{aligned} E_p^{HF} &= -(1 - \alpha\gamma_p)|E_J| - \frac{\tau_p}{\Gamma_p^2 - E_J^2}, \\ \tau_p &= \sqrt{(\alpha^2 - R^2)\Gamma_p^2 V_p^4 + (2J(\Gamma_p^2 - E_J^2) - |E_J|V_p^2)^2 R^2}. \end{aligned} \quad (9)$$

Считается, что смещенный локализованный уровень $E_J = E_0 - Jn_L$ пересекает нижнюю антиферромагнитную подзону коллективизированных электронов ($E_J < 0$). При выводе использовалось приближение ближайших соседей для электронных перескоков, а также учитывались только одноузельные и внутриподрешеточные гибридизационные процессы.

На рис. 2 приведены дисперсионные зависимости тяжелофермионной зоны вдоль главного направления магнитной зоны Бриллюэна при различных значениях энергии E_0 . Нижние два графика определяют спектр тяжелых фермионов в антиферромагнитном состоянии, а верхний — в парамагнитном состоянии. Штриховые линии соответствуют зависимостям, полученным по приближенной формуле (9), сплошные линии — зависимостям, рассчитанным из уравнения (7). Видно, что увеличение энергии E_0 , приводящее согласно рис. 1 к понижению намагниченности, сопровождается сужением зоны тяжелых фермионов, а при переходе в парамагнитную фазу происходит качественное изменение структуры такой зоны.

Уменьшение ширины зоны тяжелых фермионов приводит к увеличению их эффективной массы. Величина эффективной массы электронов, нормированная на затравочную массу коллективизированных электронов $m_0 = \hbar^2/|t_1|b$ (b — параметр решетки), оценивается из выражения

$$\begin{aligned} \frac{m^*}{m_0} &= \frac{(\Gamma_0^2 - E_J^2)^2 \tau_0}{|\Gamma_0| V_0^2} \left\{ 2\alpha|E_J|\tau_0 - [(\alpha^2 - R^2)\Gamma_0^2 + (\alpha^2 + R^2)E_J^2] V_0^2 + 4JR^2|E_J|(\Gamma_0^2 - E_J^2) \right\}^{-1}. \end{aligned}$$

Характер увеличения эффективной массы электронов при росте энергии E_0 продемонстрирован на рис. 3. Видно, что в окрестности квантовой критической точки ($E_0 \approx -0.95$) проявляется аномальная зависимость массы от контрольного параметра. В правой окрестности перехода антиферромагнетик–парамагнетик эффективная масса становится отрицательной. Это означает, что при переходе че-

на, связываемая с зоной тяжелых фермионов. Для этой энергетической полосы можно получить приближенное аналитическое выражение [20], определяющее квазимпульсную зависимость зоны тяжелых фермионов в антиферромагнитной фазе:

рез квантовую критическую точку происходит смена типа носителей тока.

Условие, определяющее сильную ренормировку массы, имеет вид

$$E_0 = -\frac{V_0^2}{4J} \frac{\alpha - R}{R} + Jn_L. \quad (10)$$

При анализе этого выражения учтено, что концентрация локализованных электронов и намагниченность зависят от энергии E_0 .

Согласно условию (10) при самосогласованном подходе расходимость массы тяжелых фермионов происходит вблизи квантовой критической точки. При этом расходимость массы коррелирует с модификацией зоны тяжелых фермионов при квантовом фазовом переходе (рис. 2). В качестве параметра, описывающего представленную модификацию, выберем ширину зоны тяжелых фермионов для главного направления:

$$\begin{aligned} W_{HF} &= -\frac{\alpha V_0^2 \Gamma_0^2}{(\Gamma_0^2 - E_J^2) |E_J|} + \\ &+ \frac{1}{|E_J|} (2J|E_J| + V_0^2) R + \frac{\tau_0}{\Gamma_0^2 - E_J^2}. \end{aligned} \quad (11)$$

Нетрудно убедиться, что при уменьшении намагниченности и увеличении энергии E_0 ширина зоны уменьшается. В парамагнитной области происходит инверсия квазимпульсной зависимости энергетического спектра по сравнению с зависимостью спектра в антиферромагнитной фазе. Отсюда следует, что по мере уменьшения ширины зоны в антиферромагнитной фазе может реализоваться ситуация, когда возникнет предельно узкая зона с большой эффективной массой. Можно показать, что одним из решений уравнения $W_{HF} = 0$ является выражение (10), при котором ранее была показана расходимость эффективной электронной массы. Таким образом, расходимость массы электронов связана с сильным редуцированием зоны тяжелых фермионов. Образование слабодисперсной узкой зоны, в свою очередь, свидетельствует о близости квантового фазового перехода.

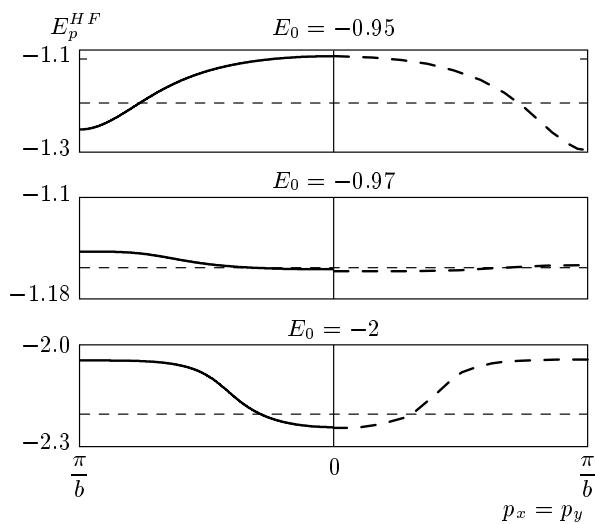


Рис. 2. Модификация квазичастичной зоны, соответствующей тяжелым фермионам, при увеличении энергии E_0 и переходе из антиферромагнитной фазы (два нижних графика) в парамагнитную фазу (верхний график). Тонкая штриховая линия определяет положение химического потенциала. Расчетные параметры такие же, что и на рис. 1

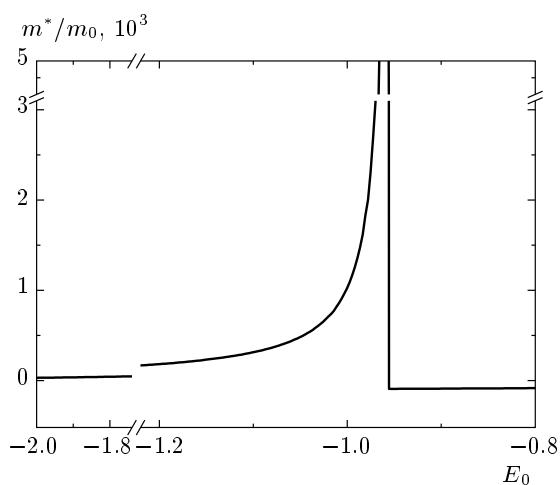


Рис. 3. Аномальное увеличение эффективной электронной массы при квантовом фазовом переходе из антиферромагнитной фазы в парамагнитную

Расширение поверхности Ферми при переходе через квантовую критическую точку продемонстрировано на рис. 4. Поверхности, обозначенные сплошными линиями, рассчитаны при различных значениях E_0 в антиферромагнитной фазе, а поверхности Ферми в парамагнитной фазе отмечены штриховыми линиями. Видно, что в антиферромагнитной фазе раз-

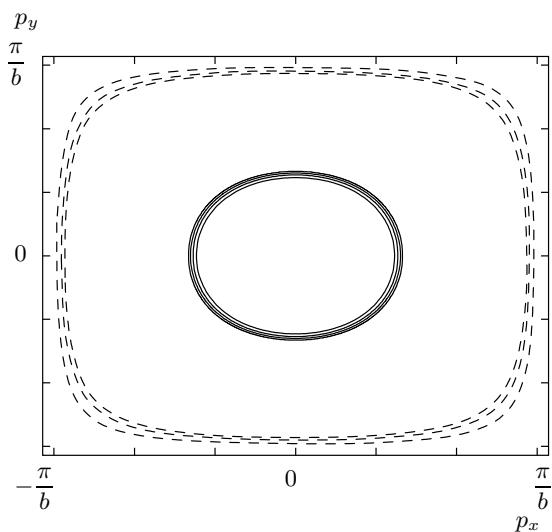


Рис. 4. Поверхности Ферми в антиферромагнитной фазе (сплошные линии), построенные при значениях энергии $E_0 = -2, -1.5, -1.2, -0.97$, и в парамагнитной фазе (штриховые линии) при $E_0 = -0.95, -0.8, -0.5$. Наименьшей энергии соответствует наименьший размер поверхности Ферми

мер поверхности Ферми практически не зависит от энергии E_0 и несколько кривых сливаются в одну. Однако при переходе через границу антиферромагнетик–парамагнетик реализуется существенное расширение поверхности Ферми. Дальнейшее увеличение энергии E_0 в парамагнитной фазе не приводит к столь большому увеличению импульса Ферми. Описанное поведение связывается со сменой типа носителей заряда в точке квантового фазового перехода. Таким образом в квантовой критической точке реализуется переход от эффективно электронных поверхностей Ферми к дырочным поверхностям Ферми. Из этого анализа можно сделать вывод о том, что при квантовом фазовом переходе будут наблюдаться существенные аномалии в эффекте Холла.

5. В предложенной модели взаимодействие (3) может индуцировать куперовскую неустойчивость. Экспериментальные данные по CeRhIn₅ указывают на то, что при давлениях, больших критического сверхпроводящая фаза имеет симметрию *d*-типа. В фазе сосуществования сверхпроводимости и антиферромагнетизма симметрия параметра порядка до конца не определена, однако высказываются предположения также о симметрии *d*-типа, но с дополнительными нодальными точками на поверхности Ферми [21]. Существенно, что рассмотрение сверхпроводящих спариваний *d*-типа на фоне антифер-

ромагнитного упорядочения приводит к качественному согласию результатов с фазовой диаграммой CeRhIn₅.

Для исследования фазы сосуществования сверхпроводимости и антиферромагнетизма необходимо использовать базисный набор операторов, позволяющий учитывать как аномальные средние, так и аномальные функции Грина. Поэтому вместо используемого ранее базиса (4) введем расширенный базис:

$$\left(X_f^{0\sigma}, Y_g^{0\sigma}, a_{f\sigma}, b_{g\sigma}, X_f^{\bar{0}0}, Y_g^{\bar{0}0}, a_{f\bar{\sigma}}^\dagger, b_{g\bar{\sigma}}^\dagger \right). \quad (12)$$

Составляя уравнения движения для нормальных и аномальных функций Грина и проводя проецирование на набор неприводимых функций Грина, соответствующих базису (12), получаем замкнутую систему уравнений. При решении этой системы принимались во внимание экспериментальные сведения о предпочтительности *d*-типа симметрии сверхпроводящего параметра порядка. В нашем случае он описывается выражением

$$\Delta_p^d = 2\Delta_0^d \sin\left(\frac{p_x b}{2}\right) \sin\left(\frac{p_y b}{2}\right). \quad (13)$$

Ввиду малости амплитуды Δ_0^d в фазе сосуществования сверхпроводимости и антиферромагнетизма энергетический спектр тяжелых фермионов незначительно модифицируется по сравнению со спектром, определяемым выражением (9). Поэтому квазичастичные характеристики фермионов в этой фазе будут хорошо описываться приведенными в предыдущем параграфе выражениями.

Уравнения самосогласования для сверхпроводящей фазы допускают решения, при которых симметрия параметра порядка может отличаться от симметрии *d*-типа. Проведенный анализ показал, что без антиферромагнитного порядка сверхпроводящая фаза с симметрией *d*-типа имеет более высокие значения критической температуры, а значит и большую энергию конденсации. Это соответствует экспериментальной ситуации. Появление антиферромагнитного упорядочения, как показывают расчеты, может приводить к изменению результата конкуренции между сверхпроводящими фазами с симметрией параметра порядка *d*- и *s*-типов. Однако при малых значениях антиферромагнитного параметра порядка его влияние будет мало и *d*-фаза будет предпочтительней. Полный анализ этого вопроса выходит за рамки данной статьи и будет выполнен в ходе дальнейших исследований.

6. В заключение отметим, что включение обменного взаимодействия в подсистеме локализованных

электронов приводит к возможности реализации антиферромагнитной фазы, сверхпроводящей фазы, а также микроскопически однородной фазы сосуществования сверхпроводимости и антиферромагнетизма. Обнаружен режим, при котором происходят аномально резкое увеличение эффективной массы электронов и расширение поверхности Ферми аналогично тому, как это имеет место в ряде редкоземельных интерметаллических систем при увеличении давления. Показано, что расходимость массы тяжелых фермионов реализуется внутри антиферромагнитной фазы, но в близкой окрестности к точке квантового фазового перехода в парамагнитную фазу. Расходимость массы сопровождается формированием слабодисперсной зоны тяжелых фермионов. Такое поведение *f*-электронов реализуется только вблизи квантовой критической точки. В области антиферромагнитной фазы, удаленной от квантового фазового перехода, увеличение намагниченности антиферромагнитной подрешетки приводит к уменьшению эффективной электронной массы.

Авторы благодарны К. Кикоину и Д. Дзебисашвили за полезные замечания.

Работа выполнена в рамках Программы Президиума РАН «Квантовые мезоскопические и неупорядоченные структуры», а также при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-02-00251), регионального РФФИ (грант «Сибирь» № 11-02-98007), РФФИ для молодых ученых (грант № 12-02-31130) и в рамках Соглашения 14.132.21.1410 Министерства образования и науки РФ, а также гранта Президента РФ (МК-526.2013.2).

ЛИТЕРАТУРА

1. С. М. Стишов, УФН **174**, 853 (2004).
2. В. Ф. Гантмахер, В. Т. Долгополов УФН **178**, 3 (2008).
3. T. Mito, S. Kawasaki, Y. Kawasaki et al., Phys. Rev. Lett. **90**, 077004 (2003).
4. S. Elgazzar, I. Opahle, R. Hayn, and P. M. Oppeneer, Phys. Rev. B **69**, 214510 (2004).
5. K. Haule, C.-H. Yee, K. Kim, Phys. Rev. B **81**, 195107 (2010).
6. J. A. Hertz, Phys. Rev. B **14**, 1165 (1976).
7. A. J. Millis, Phys. Rev. B **48**, 7183 (1993).

8. Q. Si, S. Rabello, K. Ingersent, and J. L. Smith, *Nature* **413**, 804 (2001).
9. P. Gegenwart, Q. Si, and F. Steglich, *Nature Phys.* **4**, 186 (2008).
10. H. Shishido, R. Settai, H. Harima, and Y. Ōnuki, *J. Phys. Soc. Jpn.* **74**, 1103 (2005).
11. Л. Б. Иоффе, А. Дж. Миллис, *УФН* **168**, 672 (1998).
12. T. Park, V. A. Sidorov, F. Ronning et al., *Nature* **456**, 366 (2008).
13. M. Yu. Kagan and V. V. Val'kov, *ЖЭТФ* **140**, 179 (2011).
14. S. Nakatsuji, D. Pines, and Z. Fisk, *Phys. Rev. Lett.* **92**, 016401 (2004).
15. S. Watanabe and K. Miyake, *J. Phys. Soc. Jpn.* **79**, 033707 (2010).
16. А. Ф. Барабанов, К. А. Кикоин, Л. А. Максимов, *ТМФ* **20**, 364 (1974).
17. В. А. Москаленко, *ТМФ* **110**, 308 (1997).
18. В. В. Вальков, Д. М. Дзебисашвили, *ТМФ* **157**, 235 (2008).
19. Н. М. Плакида, *ТМФ* **5**, 147 (1970).
20. В. В. Вальков, Д. М. Дзебисашвили, *ЖЭТФ* **137**, 341 (2010).
21. Y. Bang, M. J. Graf, A. V. Balatsky, and J. D. Thompson, *Phys. Rev. B* **69**, 014505 (2004).